

DHA[®]

QJ/DHA 09.21-2018

20N60

N-沟道 MOSFET 功率晶体管

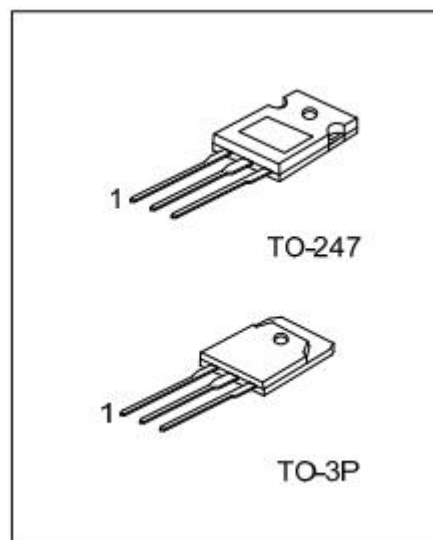
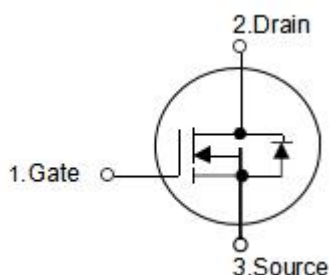
描述

20N60 是一款采用先进技术的N沟道增强型功率MOSFET，为客户提供平面条纹和DMOS技术。该技术专门用于实现最小的导通电阻和卓越的开关性能。它还可以承受雪崩和换向模式下的高能脉冲。

用途

20N60 广泛应用于电机控制，UPS，DC斩波器以及开关模式和谐振模式电源。

等效电路图

电参数 (T_{amb} = 25°C)

缩写	参数	单位	最小值	典型值	最大值	测试条件
BV _{DSS}	漏极-源极 击穿电压	V	600	-	-	V _{GS} = 0 V, I _D = 250 μA
I _D	漏极连续电流	A	-	-	20.0	T _J = 25 °C
R _{DS(on)}	静态 漏极-源极 导通电阻	Ω	-	0.32	0.45	V _{GS} = 10 V, I _D = 10 A
V _{GS(th)}	栅极门限电压	V	2.0	-	4.0	V _{DS} = V _{GS} , I _D = 250 μA
I _{DSS}	漏极-源极 漏电流	μA	-	-	1	V _{DS} = 600 V, V _{GS} = 0 V
I _{GSS}	栅极-源极 漏电流	nA	-	-	100	V _{GS} = ± 20 V, V _{DS} = 0 V
T _J	工作结温	°C	- 55 ~ +150			
T _{STG}	储存温度范围	°C				